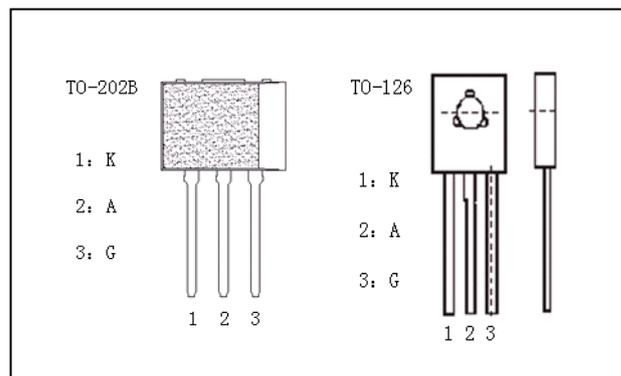


单向可控硅—TSE2P4M

TSE2P4m 主要应用于摩托车点火器电路中，还可广泛应用于各种万能开关器、小型马达控制器、彩灯控制器、漏电保护器、灯具继电器激励器、逻辑集成电路驱动、大功率可控硅门极驱动等线路控制。



1、特点

- 通态压降低
- 断态重复峰值电压高
- 触发灵敏度高
- 可靠性好
- 封装型式: T0-126, T0-202

2、电特性

极限参数 (Ta=25℃)

参数名称	符号	额定值	单位
断态重复峰值电压	V_{DRM}	600	V
反向重复峰值电压	V_{RRM}	600	V
通态平均电流	$I_{T(AV)}$	2	A
通态峰值电流	$I_{T(RMS)}$	3	A
通态不重复浪涌电流	I_{TSM}	20	A
结温	T_J	125	℃
贮存温度	T_{atg}	-40 ~ 125	℃

电参数 (Ta=25℃)

参数名称	符号	单位	规范值			测试条件
			最小值	典型值	最大值	
断态重复峰值电压	V_{DRM}	V	600	650		
反向重复峰值电压	V_{RRM}	V	600	650		$I_R=50\mu A$
断态重复峰值电流	I_{DRMI}	μA			20	$V_{DRM}=600V$
通态峰值电压	V_{TM}	V		1.3	1.7	$I_T=4A$
维持电流	I_H	mA			5	$I_T=0.1A, I_{GT}=0.2mA$
关闭电流	I_L	mA		0.17	10	$V_D=12V, I_{GT}=0.1A$
控制极触发电流※	I_{GT}	μA	10	30	100	$V_D=6V, R_L=100\Omega$
控制极触发电压	V_{GT}	V	0.5		0.8	$V_D=6V, R_L=100\Omega$
控制极最大电流	I_{GM}	A			0.5	
控制极最高电压	V_{GM}	V			5	
控制极最高反向电压	V_{RGM}	V			5	
电压上升速率	dV/dt	$V/\mu s$		50		$V_{DM}=67\%V_{DRM}, T_j=110^\circ C, R_L=100\Omega$
电流上升速率	dI_T/dt	$A/\mu s$			50	$I_T=10A, I_c=50mA, dI_c=50mA/\mu s$
控制极不触发电压	V_{GD}	V	0.1			$V_{DRM}=400V, R_{GR}=1K\Omega, T_j=110^\circ C$

※: 该参数与环境温度有关